

碳化硅晶体生长炉

Silicon Carbide Crystal Growth Furnace



TDL85P



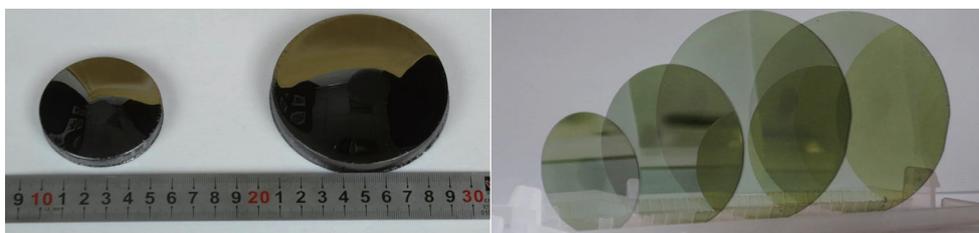
主要技术与性能指标

- 碳化硅晶体直径 ≥ 6 英寸
- 生长腔体真空度极限真空优于 5.0×10^{-5} Pa
- 生长腔体保压 12 h 后真空度 ≤ 5 Pa
- 生长腔压力控制范围 100—90 000 Pa
- 最高加热温度 ≥ 2600 °C
- 共 6 路特气（包括 Ar、N₂、H₂ 3 种气体）

主要应用

用于以 SiC 为代表的晶体材料制备

代表性应用成果



碳化硅晶体

碳化硅晶片

主要用户单位	中国科学院上海硅酸盐研究所、中国科学院物理研究所、北京天科合达半导体股份有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、北京世纪金光半导体有限公司等
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
联系方式	万向明 024-23826819, 13998191237 wanxm@sky.ac.cn